НЕЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ СФЕРИЧЕСКОГО ЖИГ-РЕЗОНАТОРА

А. В. Васильев, А. А. Игнатьев

Саратовский государственный университет Россия, 410012, Саратов, Астраханская, 83 E-mail: kbkt@renet.ru

Приведена нелинейная модель сферического ЖИГ-резонатора для малых (милливаттных) уровней мощности в диапазоне частот от 0,7 до 4 ГГц.

Ключевые слова: ЖИГ-резонатор, эквивалентная схема, нелинейная модель.

Nonlinear Model of Spherical YIG-resonator

A. V. Vasiliev, A. A. Ignatiev

Given a nonlinear model of spherical YIG-resonator for small (mW) power levels in the frequency range from 0,7 to 4 GHz.

Key words: YIG-resonator, equivalent circuit, nonlinear model.

Гетеромагнитные устройства и микросистемы автогенераторного типа имеют в своем составе различные виды и топологии ферритовых резонаторов (ФР) [1], которые представляют собой сферы из монокристаллических ферритов прямоугольные резонаторы из эпитаксиальных пленок [1], ферритов [2], массивы магнитных углеродных нанотрубок ИЗ диэлектрическом основании [3] или сфероиды из разных наноразмерных магнитных материалов [4]. В [5, 6] показан нелинейный характер поглощения входной СВЧ-мощности резонаторами на основе объемных ферритов (сферы, призмы).

В большинстве случаев при проектировании СВЧ-генератора с ЖИГрезонатором используется линейная эквивалентная схема. Варианты такой схемы приведены в [7, 8]. Блок-схема СВЧ-генератора, в которой ЖИГрезонатор заменен на линейную эквивалентную схему, приведена на рис. 1.

Применение в расчетах линейных эквивалентных схем сферических ФР в различных участках частотного диапазона (от УВЧ до ТВЧ) на различных уровнях мощности показало их ограниченный характер [1]. Так, расчетные значения центральной частоты генерируемого сигнала, уровень выходной ширина спектральной линии, уровень фазовых мощности, автогенераторов центральной гетеромагнитных перестройка частоты милливаттного уровня мощности на сферических ФР в диапазоне частот 1 ГГц не соответствовали экспериментальным данным.

В статье предложена нелинейная модель ЖИГ-резонатора, разработанная в среде САПР *Microwave Office*. Модель построена на основе экспериментально полученных характеристик ЖИГ-резонатора (уровней поглощения входного сигнала ферритовым резонатором на различных

уровнях мощности от 0,1 мкВт (-40 дБм) до 200 мВт (+23 дБм) в диапазоне частот от 500 МГц до 4 ГГц).

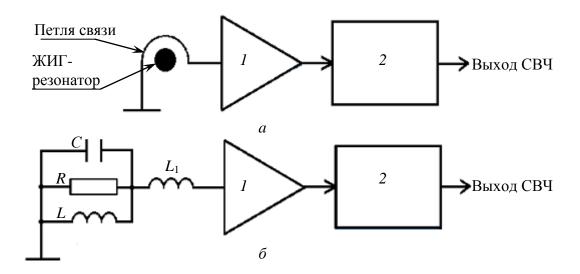


Рис. 1. Генератор с ЖИГ-резонатором: a — блок-схема; δ — схема генератора с линейной эквивалентной схемой ЖИГ-резонатора; l — активный элемент с отрицательным сопротивлением; 2 — цепь согласования; L_1 — индуктивность петли связи с ЖИГ-резонатором; C, R и L — емкость, активное сопротивление и индуктивность ЖИГ-резонатора соответственно

Для исследований был выбран сферический ферритовый резонатор 30КГ диаметром $0.8 \, \text{MM}$ c намагниченностью насыщения $4\pi M_{\rm S} = 360 \, \Gamma {\rm c}$ и шириной $\Delta H = 0.3 \, \Im$ линии ферромагнитного резонанса (ΦMP) [9]. Резонатор размещен в центре петли связи (см. рис. 1, a), которая представляет собой один виток (диаметр 0,85 мм) медной проволоки (диаметр 0,1 мм). Виток смонтирован на плате из текстолита размером 34×19 мм и толщиной 0,5 мм. Вся конструкция смонтирована в корпусе с СВЧ-разъемами. Для измерения характеристик резонатора устройство устанавливалось электромагнита, обеспечивающего зазор подмагничивания резонатора H_0 так, чтобы линии магнитной индукции лежали в плоскости витка связи (перпендикулярно монтажной плате). Блоксхема экспериментальной установки приведена на рис. 2.

Сигнал фиксированной частоты (500, 600, 700, 750, 790, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 МГц) подавался на исследуемый резонатор, а уровень сигнала, прошедшего через него, определялся с помощью анализатора спектра. Поле электромагнита устанавливалось так, чтобы частота ФМР совпала с частотой сигнала, подаваемого на вход резонатора. При этом снималась зависимость коэффициента передачи K резонатора от уровня входной мощности $P_{\rm вx}$. Полученные результаты представлены на рис. 3.

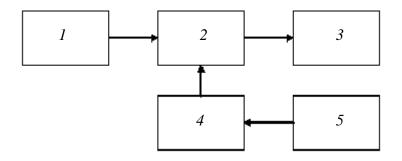


Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки: 1 — генератор СВЧ-сигналов; 2 — исследуемое устройство; 3 — анализатор спектра; 4 — электромагнит; 5 — блок питания электромагнита

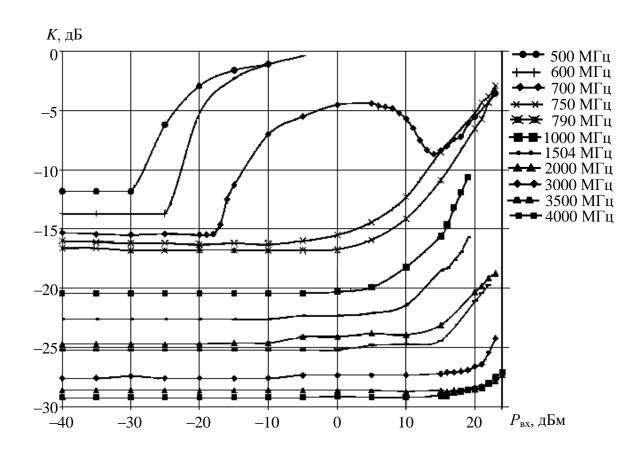


Рис. 3. Зависимость коэффициента передачи K от уровня мощности входного сигнала на частоте Φ MP

Аномальное поведение зависимости K(P) на частотах 500 МГц, 600 МГц и 700 МГц обусловлено, по всей видимости, ненасыщенным режимом работы ферритового резонатора (напомним, что использовался резонатор 30КГ с $4\pi M_{\rm S}=360$ Гс). Остальные зависимости K(P) носят качественно предсказуемый характер.

По полученным характеристикам (см. рис. 3) можно определить области работы ферритового резонатора в линейном (горизонтальные участки зависимости K(P)) и нелинейном режимах.

Нелинейная модель ЖИГ-резонатора рарабатывалась на частоте (998,2 МГц) близкой к 1 ГГц, исходя из практических потребностей [9].

Результаты измерения параметров ферритового резонатора 30КГ на частоте ФМР 998,2 МГц при поле подмагничивания 356,5 Э представлены на рис. 4–6.

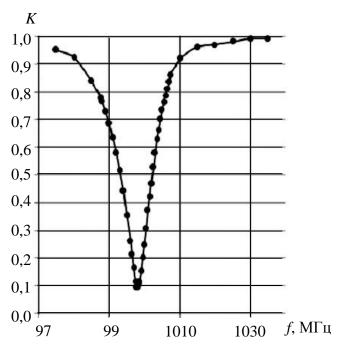


Рис. 4. Зависимость коэффициента передачи ЖИГ-резонатора от частоты f входного сигнала

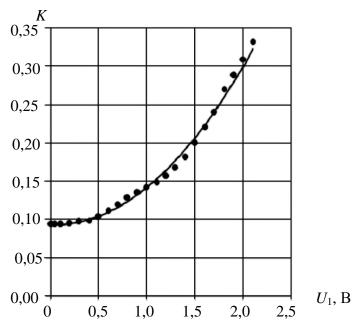


Рис. 5. Зависимость коэффициента передачи от подаваемого на резонатор напряжения U_1 . Точки — экспериментальные данные; сплошная линия — апроксимация полиномом 2-го порядка

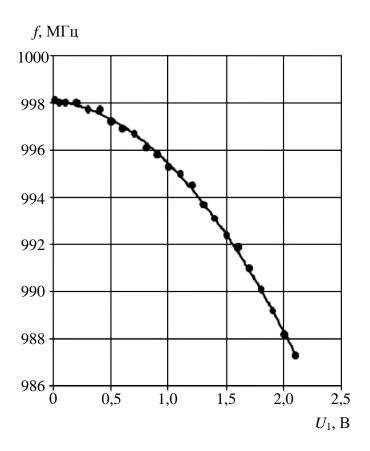


Рис. 6. Зависимость частоты ФМР от подаваемого на резонатор напряжения U_1 . Точки — экспериментальные данные; сплошная линия — апроксимация полиномом 2-го порядка

В качестве модели была использована нелинейная эквивалентная схема включения ЖИГ-резонатора, показанная на рис. 7.

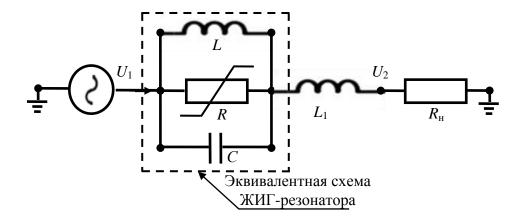


Рис. 7. Нелинейная эквивалентная схема включения ЖИГ-резонатора: U_1 — напряжение с выхода генератора; U_2 — напряжение с выхода ферритового резонатора; $R_{\rm H}$ — сопротивление нагрузки (вход анализатора спектра); L_1 —

индуктивность петли связи резонатора с линией передачи СВЧ-мощности

Параметры элементов R, L, C ЖИГ-резонатора на рис. 7 определяются по следующим формулам [8]:

$$F_{0} = \gamma H_{0},$$

$$Q = \frac{H_{0} - \frac{1}{3} 4\pi M_{S}}{\Delta H},$$

$$\omega_{0} = 2\pi F_{0},$$

$$R = 0,487Q,$$

$$L = \frac{R}{\omega_{0}Q},$$

$$C = \frac{1}{\omega_{0}^{2}L},$$
(1)

где F_0 – частота ФМР, МГц; H_0 – напряженность поля подмагничивания, Э; Q – добротность RLC-контура; ΔH – ширина резонансной линии ФМР, Э (для КГ30 это 0,3 Э); $4\pi M_S$ – намагниченность насыщения ЖИГ-резонатора, Гс (для КГ30 это 360 Гс); $\gamma = 2.8$ МГц/Гс – гиромагнитное отношение; ω_0 – циклическая частота.

Коэффициент передачи на резонансной частоте определяется по формуле

$$\dot{K} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{U}_1} = \frac{R_{\rm H}}{\dot{Z} + R_{\rm H}},\tag{2}$$

где \dot{Z} – полное комплексное сопротивление ЖИГ-резонатора.

В первом приближении можно считать $\omega L_1 << R$, и сопротивление параллельного RLC контура на резонансной частоте становится чисто активным, т. е. $\dot{Z} \approx R$, тогда

$$K = \frac{R_{\rm H}}{R + R_{\rm H}},$$

$$R = R_{\rm H} \left(\frac{1}{K} - 1\right).$$
(3)

Так как K — нелинейный параметр (см. рис.3), то и R — нелинейное сопротивление. Используя экспериментальные данные (см. рис. 4—6)

$$K(U) = 0.055U^2 - 0.007U + 0.094$$

и формулу (3), получим зависимость R(U):

$$R(U) = R_{\rm H} \frac{0.906 - 0.055U^2 + 0.007U}{0.094 + 0.055U^2 - 0.007U}.$$
 (4)

Из (4) можно получить выражение для вольт-амперной характеристики (BAX) сопротивления R (рис. 8):

$$I(U) = \frac{U}{R_{\rm H}} \cdot \frac{0,094 + 0,055U^2 - 0,007U}{0,906 - 0,055U^2 + 0,007U}.$$
 (5)

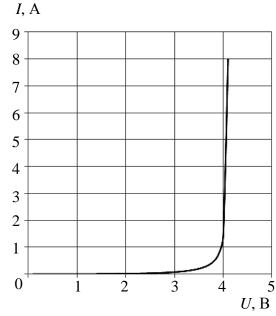


Рис. 8. Вольт-амперная характеристика нелинейного сопротивления R в нелинейной модели ЖИГ-резонатора

Подставляем нелинейное сопротивление (3) в модель резонатора, показанную на рис. 7. В среде *Microwave Office* это можно сделать двумя способами: заданием BAX сопротивления кусочно-линейной аппроксимацией или заменой его двумя встречно-параллельными диодами (рис. 9) с такими же, как на рис. 8, характеристиками. Можно подобрать BAX диодов так, чтобы они совпадали с BAX сопротивления *RLC*-контура.

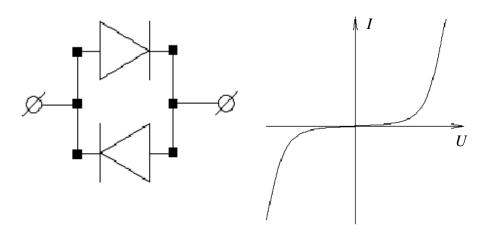


Рис. 9. Два диода, включенные встречно-параллельно и их вольтамперная характеристика

Таким образом, смоделировано насыщение ЖИГ-резонатора при переходе в нелинейный режим работы на высоких уровнях мощности. Однако, как видно из рис. 6, с в нелинейном режиме работы ЖИГ-резонатора экспериментально наблюдается изменение резонансной эквивалентной схеме ЖИГ резонатора величина изменения резонансной частоты от уровня мощности определяется индуктивностью L_1 петли связи. Зависимости K(f) при разных уровнях мощности (от -20 до +20 дБм) показаны на рис. 10. Точкам минимума зависимости K(f) соответствуют значения резонансной частоты ЖИГ-резонатора. Пунктирной показано изменение резонансной частоты от уровня мощности, подаваемой на резонатор, которое пересчитано из зависимости $f(U_1)$ (см. рис. 6). Величина индуктивности L_1 петли связи подбирается так, чтобы смещение резонансной частоты при изменении уровня входной мощности в модели совпало с экспериментально полученными данными.

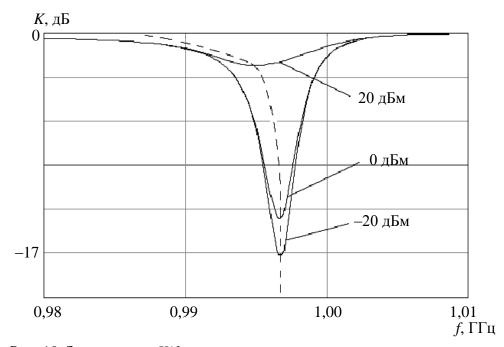


Рис. 10. Зависимость K(f) при разных уровнях мощности

Проведенный расчет в среде *Microwave Office* показывает, что предложенная модель для частоты $1 \Gamma \Gamma \mu$ достаточно корректно работает в полосе $\pm 10\%$ с точностью методической погрешности измерений параметров ЖИГ-резонатора.

Таким образом, авторами предложена нелинейная модель ЖИГ-резонатора и приведена методика ее расчета. Однако в модели не учтена зависимость коэффициента передачи на частоте ФМР от самой частоты ФМР (от внешнего подмагничивающего поля). Не учтено также и то, что с ростом частоты увеличивается диапазон линейного режима работы ЖИГ-резонатора (растет пороговая мощность [2, 5, 10]), как это видно из рис. 3. Для учета этих эффектов необходимо вводить зависимость величины R не только от напряжения, но и от частоты (с ростом частоты сопротивление должно увеличиваться). К сожалению, в среде *Містоwave Office* нет такой возможности. Поэтому приходится ограничиваться узкополосной моделью резонатора, что достаточно для многих практических случаев [9].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1. *Игнатьев А. А.*, *Ляшенко А. В.* Гетеромагнитная микроэлектроника. Микросистемы активного типа. М. : Наука, 2007. 612 с.
- 2. *Игнатьев А. А.*, *Ляшенко А. В.* Магнитоэлектроника СВЧ-, КВЧ-диапазонов в пленках ферритов. М.: Наука, 2005. 877 с.
- 3. Игнатьев А. А., Куликов М. Н., Васильев А. В., Митин И. В. Экспериментальные исследования возбуждения СВЧ-колебаний в магнитных углеродных нанотрубках на микрополосковых устройствах // Гетеромагнитная микроэлектроника: сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2008. Вып. 3: Гетеромагнитная микро- и наноэлектроника. Прикладные аспекты. С. 81–85.
- 4. Глебов В. А., Глебов А. В., Сафронов Б. В., Шингарев Э. Н. Кристаллические магнитные материалы // Цветные металлы. 2011. № 1. С. 83–86.
- 5. $\mathit{Лакс}$ Б., $\mathit{Баттон}$ К. Сверхвысокочастотные ферриты и ферримагнетики. М.: Мир, 1965. 675 с.
- 6. *Гуревич А.* Γ . Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. М.: Наука, 1973. 588 с.
- 7. *Ильченко М. Е., Кудинов Е. В.* Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1973. 175 с.
- 8. Ollivier P. M. Microwave YIG-tuned transistor oscillator amplifier design: application to C band // IEEE J. of solid-state circuits. February. 1972. Vol. sc-7, Nolemode 1 P. 54–60.
- 9. *Самолданов В. Н.*, *Луконин И. С.* Разработка автогенератора с ЖИГ-резонатором для датчика слабых магнитных полей // Гетеромагнитная микроэлектроника : сб. науч. тр. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2008. Вып. 5 : Прикладные аспекты микро- и наноэлектроники. С. 35–51.
 - 10. Моносов Я. А. Нелинейный ферромагнитный резонанс. М.: Наука, 1971. 376 с.